

Si-Fotodioden

Typ	Grenzwerte					Kennwerte bei $T_a = 25\text{ °C}$					Bauform
	Sperrspannung U_R (V)	Sperrstrom I_R (mA)	Betriebstemperatur T_a (°C)	Sperrstrom I_{R1} (μ A) I_{R2} (μ A)		Gesamtkapazität bei U_R C_{tot} (pF) (V)		Empfindlichkeit S_λ (A/W) bei λ (nm)		Wellenlänge λ_{max} (nm)	
SP 101	25	1	-40 ... 70	0,1	20	≤ 40	20	0,3	500	820	46
SP 102	25	0,1	-40 ... 70	0,004	1,6	≤ 10	20	0,6	820	820	46
								0,45	900		46
								0,3	500		47
								0,6	820		47
SP 103	25	3	-40 ... 70	0,15	70	≤ 100	20	0,45	900	820	47
								0,3	500		46
								0,6	820		46
SP 106	25		-25 ... 85			≤ 35	10	0,45	900	900	46
								0,5	850		57

1) bei $E_e = 0$; $U_R = 20\text{ V}$ 2) bei $E_v = 1000\text{ Lux}$ und einer Farbtemperatur der Strahlungsquelle von 2856 K; $U_R = 20\text{ V}$

Typ	Gehäuse Bemerkungen	Dunkelsperrstrom bei $E_e = 0\text{ lx}$ I_{R0} (nA) (typ.)	Betriebsspannung U_B (V)	spektrale Empfindlichkeit bei $U_R = 10\text{ V}$ $\lambda_p = 850\text{ nm}$ S_λ (A/W) (typ.)	Impulsanstiegszeit t_r (ns)	Bauform
SP 114	TO 39-Sockel mit Planglasfenster Avalanche-Fotodiode	1	140 ... 300	0,4	200 (typ.)	48

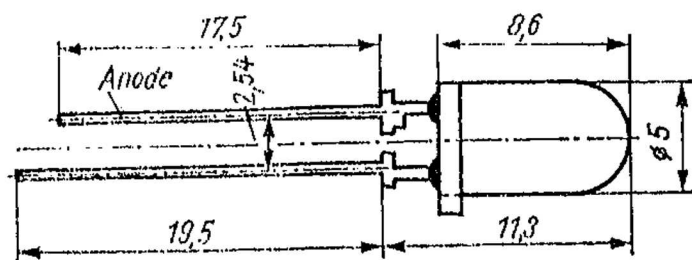


Bild 45

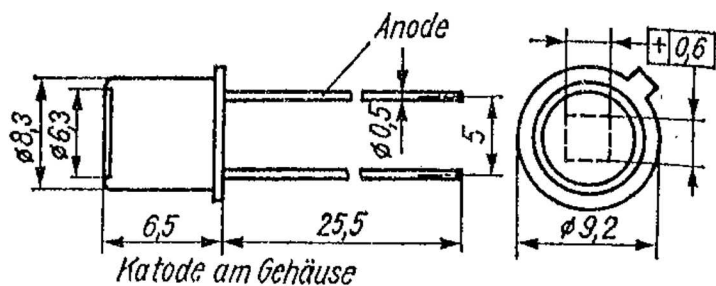


Bild 46

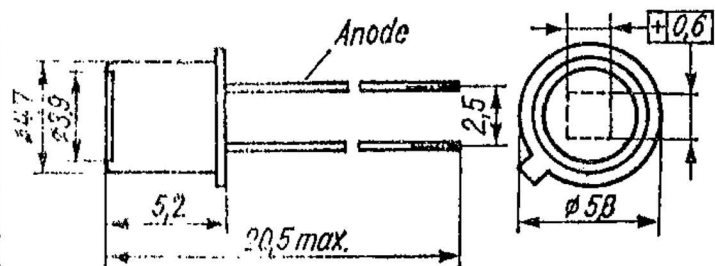


Bild 47

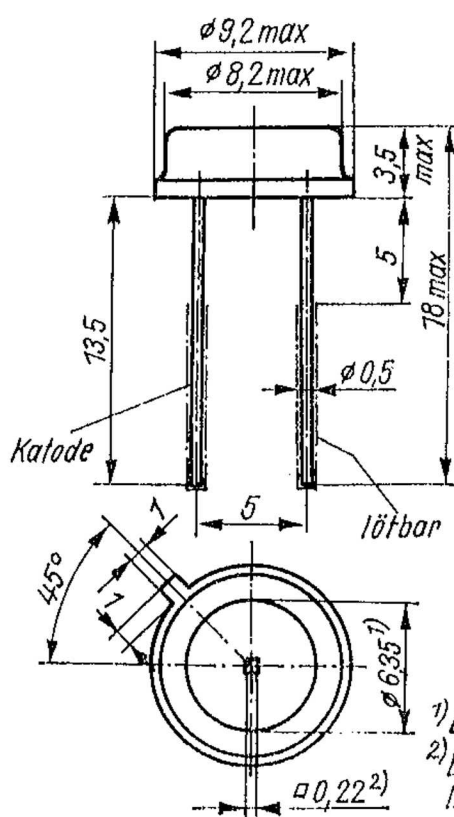


Bild 48

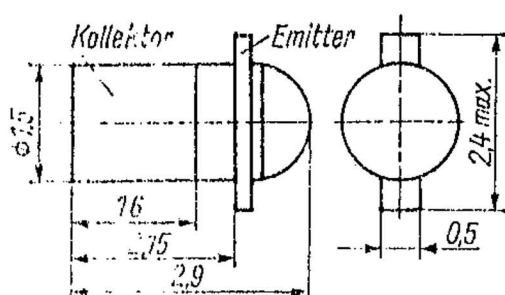


Bild 49

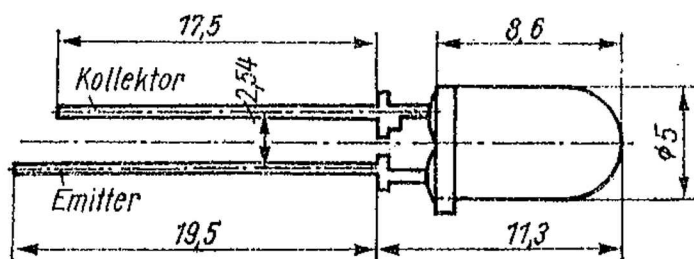


Bild 50

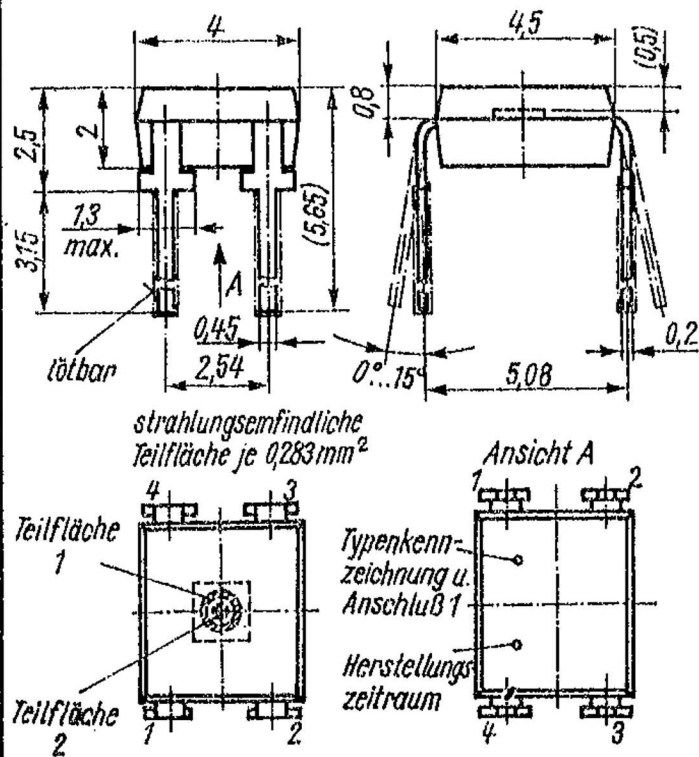


Bild 55

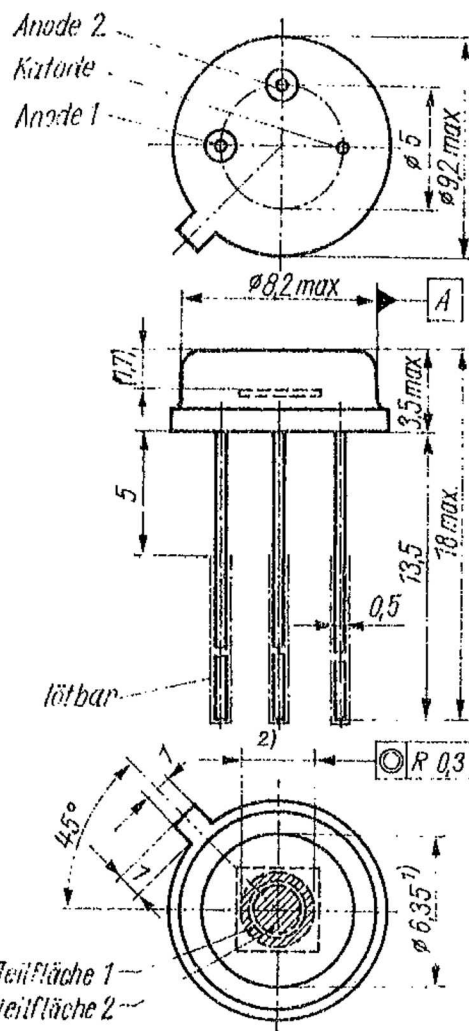


Bild 56

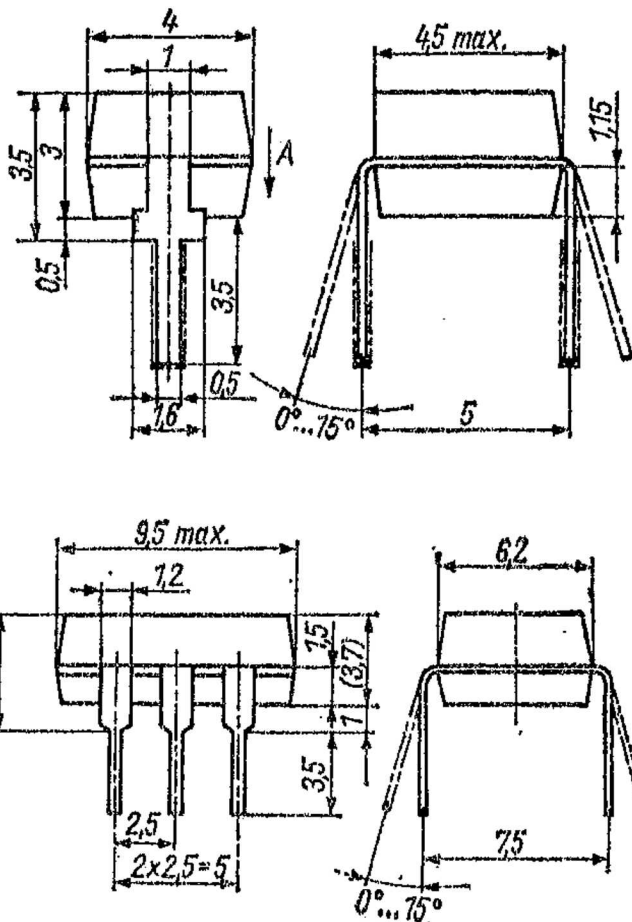


Bild 58

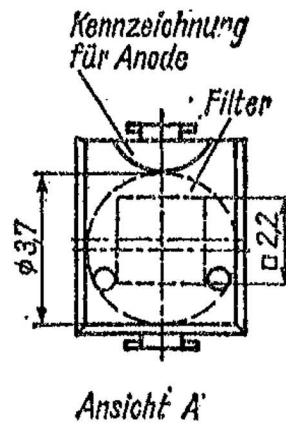


Bild 57

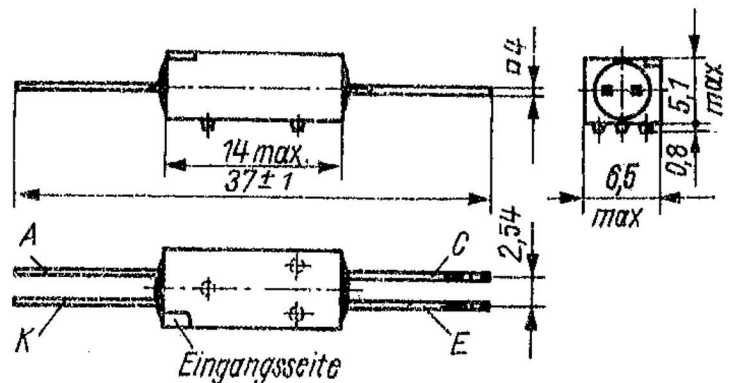


Bild 59